

图书基本信息

书名：<<氮化物宽禁带半导体材料与电子器件>>

13位ISBN编号：9787030367174

10位ISBN编号：7030367170

出版时间：2013-1

出版时间：科学出版社

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

<<氮化物宽禁带半导体材料与电子器件>>

内容概要

《氮化物宽禁带半导体材料与电子器件》内容包括：氮化物材料的基本性质、异质外延方法和机理，HEMT材料的电学性质，AlGaN / GaN和InAlN / GaN异质结的生长和优化、材料缺陷分析，GaNHEMT器件的原理和优化、制备工艺和性能、电热退化分析，GaN增强型HEMT器件和集成电路，GaN MOS - HEMT器件，最后给出了该领域未来技术发展的几个重要方向。

《氮化物宽禁带半导体材料与电子器件》可供微电子、半导体器件和材料领域的研究生与科研人员阅读参考。

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>